



- The high-temperature data carriers must undergo adequate stress tests within the proposed temperature processes before deployment. Otherwise, their durability cannot be guaranteed when exposed to temperatures outside the denoted range.
- Pamięć EEPROM 112 bajtów
- Numer seryjny TID: 8 bajt
- Do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej

Zasada działania

Kształt strefy transmisji głowic czytająco-zapisujących UHF zależny jest od samej głowicy i nośnika danych.

Podane odległości odczytu/zapisu są wartościami standardowymi zmierzonymi w warunkach laboratoryjnych.

Odległości te mogą ulec zmianie z uwagi na tolerancję komponentów, warunki montażowe, warunki otoczenia oraz wpływ materiałów (szczególnie metalu).

Dlatego niezbędny jest test aplikacji w rzeczywistych warunkach (szczególnie z wykonaniem zapisu/odczytu "w locie")!

Typ	TW865-868-Q22L36-M-HT-B112
Nr kat.	7030450
Dane transferu	zmienne pole elektromagnetyczne
Częstotliwość pracy	865...868 MHz
Typ pamięci	EEPROM
Chip	Alien Higgs 3
Rozmiar pamięci	112 bajt
Pamięć	odczyt/zapis
Pamięć dostępna	64 bajt
EPC memory	12 byte
Liczba operacji odczytu	bez ograniczeń
Liczba operacji zapisu	10 ⁵
Typowy czas odczytu	2 ms/bajt
Typowy czas zapisu	3 ms/bajt
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
Minimum distance to metal	0 mm
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Długość obudowy	36 mm mm
Szerokość obudowy	22 mm mm
Wysokość obudowy	7 mm mm
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, czarny, TPE
Stopień ochrony	IP67
Packaged quantity	1
Uwaga dotycząca produktu	High-temperature, for direct mounting on metal